## Calculo de Activacion de Transistor de potencia

Gutierrez Olivares Rogelio

29 de octubre de 2019

Parametros Los parametros tomados en cuenta para los transistores son los siguientes:

1-Impedancia de entrada: Alta(1010ohmios)

2-Ganancia de corriente: Alta (107)

3-Resistencia ON (saturacion): Media/alta

4-Resistencia OFF (corte): Alta 5-Voltaje aplicable: Alto(1000V)

6-Maxima temperatura de operacion: Alta (200grados)

7-Frecuencia de trabajo: Alta (100-500 Khz

## Calculos

Tenemos que la tension del colector-emisor viene dada como:

Sustituyendo, tendremos que:

$$Vce=Vcc-R(Vcc/R)(t/tr)=Vcc*(1-(t/tr))$$

Nosotros asumiremos que el Vce en saturación es despreciable en compración con Vcc asi, la potencia instantanea por el transistor durante este intervalo viene dada por:

$$p=Vce*Ic=Vcc*Icmax(t/tr)(1-(t/tr))$$

La energia Wr, disipada en el transistor durante el tiempo de subida esta dada por la integral de la potencia durante el intervalo del tiempo de caida, con el resultado:

$$Wr = ((vcc*Icmax)/4)((2tr)/3)$$

De forma similar, la energia (Wf) disipada en el transistor durante el tiempo de caida, viene dado como:

$$Wf = ((vcc*Icmax)/4)((2tf)/3)$$

La potencia media resultante dependeria de la frecuencia con que se efectue la conmutacion :

Pav= 
$$f^*(Wr+Wf)$$

Un ultimo paso a considerar tr despreciable frente a tf, con lo que no cometeriamos un error apreciable si finalmente dejamos la potencia media, tras sustituir como:

$$Pc(av) = ((Vcc*Icmax)/6)(tf)(f)$$